

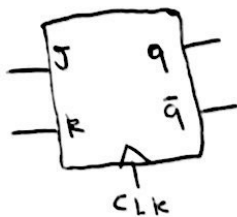


Memorias

1. El proceso de escritura en una RAM consiste en situar datos en la memoria, mientras que el proceso de lectura consiste en dejar ver el contenido almacenado en una posición de memoria.
2. Una memoria de 32×8 contiene 32 palabras, de 8 bits cada una, con una capacidad total de 256 bits.
3. Una Memoria Flash es un dispositivo de almacenamiento no volátil. (Aunque también la memoria ROM no es volátil.)
4. Una ROM de $65\,536 \times 8$ necesitará 16 líneas de dirección.
5. La RAM estática utiliza celdas de memoria similares a los ff.
6. Una ROM de $131\,072 \times 8$ tendrá una capacidad total de 1,048,576 bits

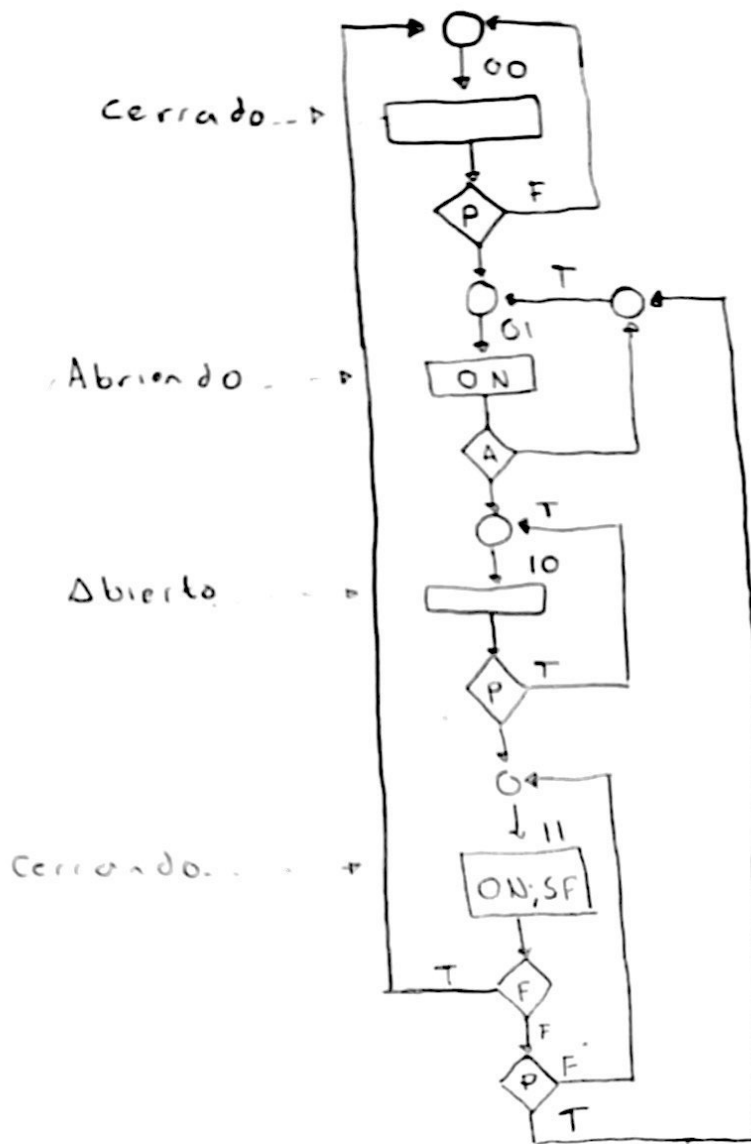
Carta ASM

Obtener la carta ASM del siguiente Flip Flop



J	K	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	Q

Siguiente
página →

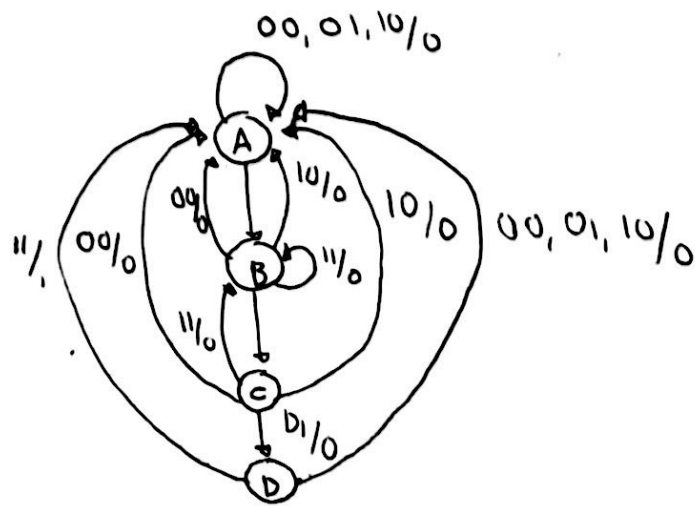


Detectores de secuencia

Oblenga el DTE para una FSM del tipo Mealy y Moore (mini-05) de un circuito con dos entradas, X y Y , dado una salida $Z=1$ cuando los últimos ciclos del reloj, las entradas hayan sido 11, 01, 011. Justifique su respuesta por medio de Falstad para cada autómata.

→
Srg. página.

Mealy



	x	y	A	B	D _A /A	D _B /B	Z
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0	0
4	0	1	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0
10	1	0	1	0	0	0	0
11	1	0	1	1	0	0	0
12	1	1	0	0	0	1	0
13	1	1	0	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0	1	0
15	1	1	1	1	0	1	0

Mapas de K.

D ₀	xy	00	01	11	10
00	xy	0	0	0	0
01	xy	0	1	0	1
11	xy	0	0	0	0
10	xy	0	0	0	0

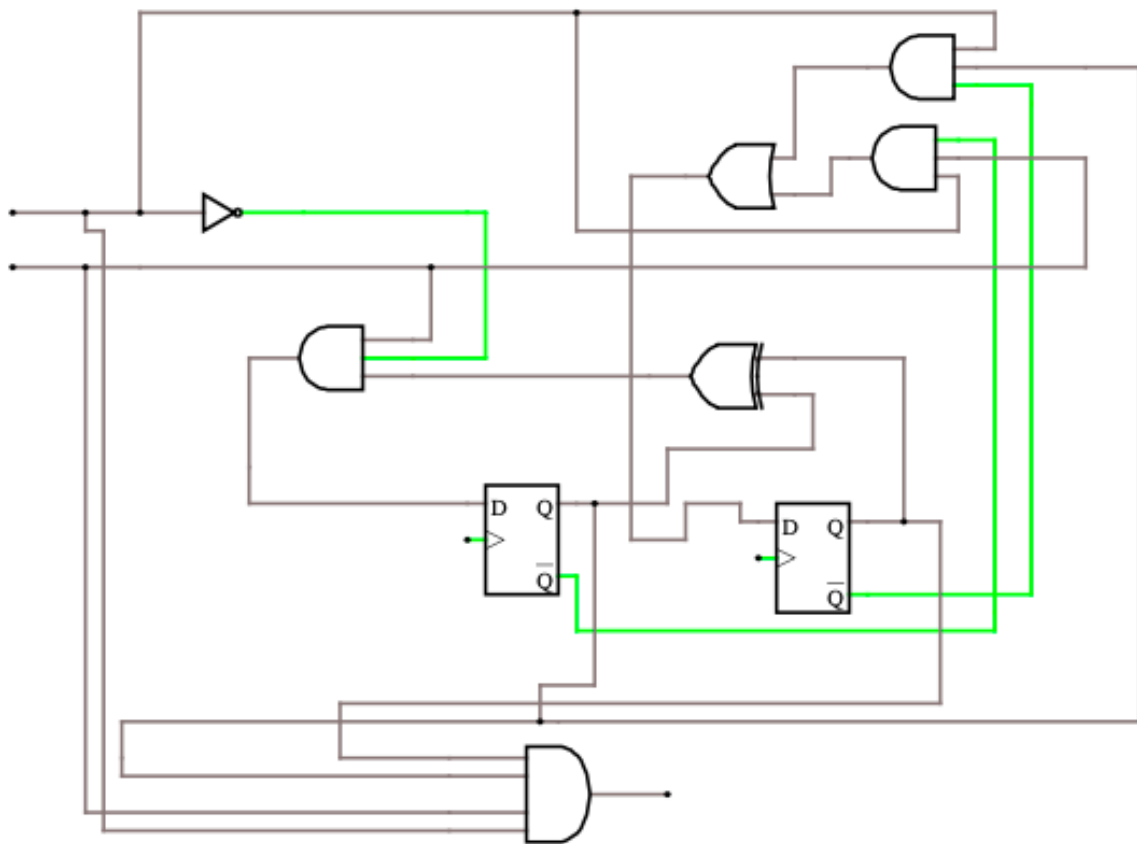
$$\begin{aligned}
 D_0 &= \bar{x}y\bar{A}B + \bar{x}yA\bar{B} \\
 &= \bar{x}y(\bar{A}B + A\bar{B}) \\
 &= \bar{x}y(A \oplus B)
 \end{aligned}$$

$$Z = x y A B$$

D _B	xy	00	01	11	10
00	xy	0	0	0	0
01	xy	0	0	0	1
11	xy	1	1	0	1
10	xy	0	0	0	0

$$D_B = x y \bar{A} + y A \bar{B}$$

Simulación



<https://tinyurl.com/yjlm22ga>